

ASAIN 0058

Saleet CR



DELPHION

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

LOT OXI WORK FILE SEXED SEXED SEXED My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Work File

Go

View: INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent

Email this to a friend

PTitle:

JP06210954A2: REVERSIBLE THERMAL RECORDING MATERIAL

Propert Title:

Erasable heat sensitive recording material - contg. dye precursor and specified

phenolic electron acceptor [Derwent Record]

PCountry:

JP Japan

Kind:

A (See also: JP03380277B2)

PInventor:

IKEDA MITSUHIRO;

YOKOTA YASURO;

HIRAISHI SHIGETOSHI:

IIDA KAZUYUKI: SANO HIDEKAZU;

PAssignee:

MITSUBISHI PAPER MILLS LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

1994-08-02 / 1992-12-25

PApplication Number:

JP1992000347032

FIPC Code:

B41M 5/26;

Priority Number:

1992-11-24 JP1992000313596

& Abstract:

PURPOSE: To provide a reversible thermal recording material capable of forming and erasing an image in good contrast and capable of holding an image stable with the elapse of time under daily living environment.

CONSTITUTION: In a reversible thermal recording material containing a usually colorless or light-colored electron donating dye precursor and an electron acceptive compd. generating a reversible hue change in the dye precursor by the difference of a cooling speed after heating, a phenolic compd having at least one 6C or more aliphatic hydrocarbon group is used as the electron acceptive compd. By this constitution, the reversible thermal recording material capable of forming and erasing in good contrast and capable of holding an image stable with the elapse of time under daily living environment can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

PINPADOC

Legal Status:

None

Get Now: Family Legal Status Report

Properties Designated Country:

DE FR GB

Family:

Show 7 known family members

Forward References:

Go to Result Set: Forward references (8)

PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
æ	<u>US6734138</u>	2004-05-11	Suzuki; Kazumi	Ricoh Company, Ltd.	Reversible thermosensitive recording material, and image recording and erasing method using the recording material
Ø	DE19813493C2	2003-12-18	Tachizawa, Shingo, Tokio/Tokyo, JP	Mitsubishi Paper Mills Limited	Reversibles, wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial
Z	<u>US6579826</u>	2003-06-17	Furuya; Hiromi	Ricoh Company	Reversible thermosensitive recording medium and image forming and erasing

View

1 page

				Limited	method using the recording medium
*	<u>US6375784</u>	2002-04-23	Ohsawa; Haruhiko	Kyodo Printing Co., Ltd	Method of manufacturing reversible heat-sensitive recording medium and reversible heat-sensitive recording medium manufactured thereby
2	<u>US6261992</u>	2001-07-17	Furuya; Hiromi	Ricoh Company, Ltd.	Reversible thermosensitive recording material and recording method and apparatus therefor
*	<u>US5977020</u>	1999-11-02	Nishioka; Makoto	Oji Paper Co., Ltd.	Thermosensitive reversible recording material
各	<u>US5702850</u>	1997-12-30	Nishioka; Makoto	New Oji Paper Co., Ltd.	Thermosensitive reversible color- developing and disappearing agent
28	<u>US5641724</u>	1997-06-24	Yamaguchi; Takehito	Ricoh Company, Ltd.	Reversible thermosensitive coloring composition and a thermosensitive recording medium using thereof

? Other Abstract Info:

CHEMABS 121(04)037807M JAP180576M000034 DERABS C93-407254 JAPABS 180576M000034









Nominate this for the Gallery...



Copyright © 1997-2004 The Thomson Corporation

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-210954

(43)公開日 平成6年(1994)8月2日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

B41M 5/26

6956-2H

B 4 1 M 5/18

101 A

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 18 頁)

特願平4-347032	(71)出願人	000005980
		三菱製紙株式会社
平成4年(1992)12月25日		東京都千代田区丸の内3丁目4番2号
	(72)発明者	池田 光弘
特願平4-158098		東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱
平4 (1992) 6月17日		製紙株式会社内
日本 (JP)	(72)発明者	横田 泰朗
特顧平4-247788		東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱
平4(1992)9月17日		製紙株式会社内
日本 (JP)	(72)発明者	平石 重俊
特願平4-247789		東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱
平4(1992)9月17日		製紙株式会社内
日本(JP)		
		最終頁に続く
	平成4年(1992)12月25日 特顧平4-158098 平4(1992)6月17日 日本(JP) 特顧平4-247788 平4(1992)9月17日 日本(JP) 特顧平4-247789 平4(1992)9月17日	平成4年(1992)12月25日 (72)発明者 特顧平4-158098 平4(1992)6月17日 日本(JP) (72)発明者 特顧平4-247788 平4(1992)9月17日 日本(JP) (72)発明者 特顧平4-247789 平4(1992)9月17日

(54) 【発明の名称】 可逆性感熱記録材料

(57)【要約】

【目的】 良好なコントラストで画像の形成・消去が可 能で、日常生活の環境下で経時的に安定な画像を保持可 能な可逆性感熱記録材料を提供することである。

【構成】 通常無色ないし淡色の電子供与性染料前駆体 と、加熱後の冷却速度の違いにより該染料前駆体に可逆 的な色調変化を生じせしめる電子受容性化合物とを含有 する可逆性感熱記録材料。炭素数6以上の脂肪族炭化水 素基を少なくとも一つ有するフェノール性化合物を電子 受容性化合物として用いることにより、良好なコントラ ストで画像の形成・消去が可能で、日常生活の環境下で 経時的に安定な画像を保持可能な可逆性感熱記録材料を 得ることができた。

たは水素原子を表し、互いに同一でも異なっていても良い。 R³ は脂肪族炭化水素基を表す。 Y は式化 2 で表される基である。

【0014】また、化1で表される化合物の中、R³の 炭素数の多い方が好ましく、R³の炭素数が5以下であるものは消色効果が十分ではない。また、R³の炭素数が23以上であるものは製造コストが高いため、R³は 炭素数6以上22以下の脂肪族炭化水素基であるものが 特に好ましい。

【0015】一般式化1で表される化合物は電子受容性 10 化合物であり、ロイコ染料を発色させる能力を持つにも係わらず、特異的に消色効果すなわち可逆効果も持ち合わせていることを本発明者等は見出した。このことは全く予期しないことであり、通常の感熱記録材料に用いている電子受容性化合物、即ち、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン、ビス(4ーヒドロキシフェニル)スルホン、4ーヒドロキシ安息香酸ベンジル等ではこのような可逆効果は全く見られない。

[0016]

【化2】

$$-X^{1}$$
 $(Ar)_{11}$ $(X^{2})_{12}$

【0017】式化2中、11、12は各々0または1の整数を表す。X¹、X²は各々少なくとも1つのヘテロ原子を有する2価の基を表し、互いに同一でも異なっていても良い。Arは置換基を有してもよい芳香族基を示し、化3で表される芳香族基が特に好ましい。

[0018] [化3]

【0019】式化3中、k1、k2は各々0または1の整数を表し、X³、X⁴は各々少なくとも1つのヘテロ原子を有する2価の基を示し、互いに同一でも異なっていても良い。k1が0のとき、R⁴は脂肪族炭化水素基、アルコキシ基、ハロゲン原子から選ばれる置換基または 40水素原子を表し、k1が1のとき、R⁴は脂肪族炭化水素基を示す。また、k2が0のとき、R⁵は脂肪族炭化水素基、アルコキシ基、ハロゲン原子から選ばれる置換*

*基または水素原子を表し、k2が1のとき、R5は脂肪 族炭化水素基を示す。

【0020】式化3中、R⁴、R⁵が脂肪族炭化水素基であるときには、R⁴、R⁵は各々炭素数6以上22以下の脂肪族炭化水素基であることが特に好ましい。

【0021】また、式化1および式化3中、 $R^1 \sim R^5$ が 脂肪族炭化水素基であるときには、 $R^1 \sim R^5$ はアルキル 基、シクロアルキル基またはアルケニル基であることが 特に好ましい。

- 7 【0022】式化2~3中、X1~X1で表される少なくとも1つのヘテロ原子を有する2価の基としては、例えばアミド結合、スルホンアミド結合、エステル結合、炭酸エステル結合、エーテル結合、スルフィド結合、チオエステル結合、カルボニル基、アミノ結合、尿素結合、チオ尿素結合、ウレタン結合、アゾメチン結合などが挙げられ、特にアミド結合、スルホンアミド結合、スルフィド結合、尿素結合、アゾメチン結合から選ばれる2価の基が特に好ましいが、本発明はこれらに限定されるものではない。
- 20 【0023】また、一般式化1で表される電子受容性化 合物のうち、一般式化4で表される化合物が特に好まし い。

[0024]

【化4】

$$(HO)_{n}$$

$$R^{1}$$

$$R^{2}$$

$$X^{s} (Ar)_{11} (X^{s})_{12}$$

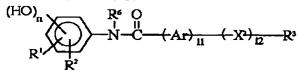
$$R^{3}$$

30 【0025】式化4中、n、11、12、R¹~R⁸、Ar、X²は上記と同じである。X⁵はアミド結合、スルホンアミド結合、スルフィド結合、尿素結合、アゾメチン結合から選ばれる結合を示す。

【0026】また、式化4中、例えば化5、化6で表されるアミド化合物、化7で表されるスルホンアミド化合物、化8で表されるスルフィド化合物、化9で表される 尿素化合物、化10、化11で表されるアゾメチン化合物等が特に好ましい。なお、式化5~化11中、n、11、12、 R^1 ~ R^3 、Ar、 X^2 は上記と同じである。

[0027]

【化5】

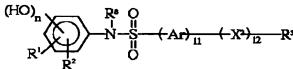


【0028】式化5中、R⁶は脂肪族炭化水素基または 水素原子を表す。

[0029]

50 【化6】

【0030】式化6中、R7は脂肪族炭化水素基または * [0031] 水素原子を表す。 【化7】



【0032】式化7中、R8は脂肪族炭化水素基または **%[0034]** 水素原子を表す。 【化9】

[0033]

(化8]

(HO)_n

[0035]

【0036】式化10中、R9は脂肪族炭化水素基また ☆【0037】 は水素原子を表す。 【化11】

$$(HO)_{n}$$

$$R^{10}$$

$$R^{2}$$

$$N = C - (Ar)_{11} - (X^{2})_{12} - R^{2}$$

は水素原子を表す。

【0039】次に、本発明による電子受容性化合物とし て好ましいものの具体例を挙げるが、本発明はこれに限 定されるものではない。

【0040】例えば、式化5で表される如きアミド化合 物としては、4′-ヒドロキシヘプタンアニリド、4′ ーヒドロキシー3-メチルオクタンアニリド、4'-ヒ ドロキシトリデカンアニリド、4′-ヒドロキシヘプタ デカンアニリド、4′-ヒドロキシノナデカンアニリ ド、3′-ヒドロキシノナデカンアニリド、4′-ヒド 50 プタデカンアニリド、

【0038】式化11中、R10は脂肪族炭化水素基また 40 ロキシー10-オクタデセンアニリド、4´ーヒドロキ シードカサンアニリド、15-シクロヘキシル-4'-ヒドロキシペンタデカンアニリド、4′-ヒドロキシー 5-テトラデセンアニリド、4'-ヒドロキシ-3'-メチルノナンアニリド、3′-シクロヘキシル-4′-ヒドロキシヘプタデカンアニリド、3′-アリル-4′ -ヒドロキシペンタデカンアニリド、4′-ヒドロキシ -3'-メトキシオクタデカンアニリド、3'-クロロ -4'-ヒドロキシオクタデカンアニリド、3'-ヒド ロキシドデカンアニリド、2′, 4′-ジヒドロキシへ

【0041】4′-ヒドロキシ-4-ヘキシルペンズア ニリド、4′-ヒドロキシー4-ドデシルペンズアニリ ド、4′-ヒドロキシ-4-テトラデシルペンズアニリ ド、4′-ヒドロキシ-4-オクタデシルベンズアニリ ド、4′-ヒドロキシ-4-ペンタデシルアミノカルボ ニルベンズアニリド、4′-ヒドロキシ-4-ヘキシル カルボニルアミノベンズアニリド、4′-ヒドロキシー 4-(ヘプチルチオ)ペンズアニリド、4′-ヒドロキ シー4-オクタデシルオキシベンズアニリド、4'-ヒ ドロキシー4-ドデシルスルホニルベンズアニリド、 4′-ヒドロキシー4-ノニルスルホニルオキシベンズ アニリド、4′-ヒドロキシ-4-ドデシルオキシスル ホニルベンズアニリド、4′-ヒドロキシ-4-ペンタ デシルアミノスルホニルベンズアニリド、4′-ヒドロ キシ-4- (N-ペンタデシリデンアミノ) ベンズアニ リド、4′-ヒドロキシ-4-(N-ヘプタデシリデン アミノ) ベンズアニリド、

【0042】4′-ヒドロキシ-3,4-ジオクチルオ キシベンズアニリド、4′-ヒドロキシー3,4,5-トリオクタデシルオキシベンズアニリド、4′-ヒドロ 20 キシー3-オクチル-4-(オクチルチオ)ペンズアニ リド、4′-ヒドロキシ-3-(ヘプタデシルチオ)-5-ペンタデシルオキシペンズアニリド、4'-ヒドロ キシー3-ヘプタデシルカルポニルアミノ-5-ドデシ ルベンズアニリド、4′-ヒドロキシ-3-オクタデシ ルアミノカルポニル-5-テトラデシルアミノカルポニ ルベンズアニリド、4′-ヒドロキシ-3-オクタデシ ルスルホニルアミノ-5-オクタデシルオキシペンズア ニリド、4′-ヒドロキシ-3-ヘプタデシルオキシス ルホニルー5ーテトラデシルオキシスルホニルベンズア 30 ニリド、4′-ヒドロキシ-3、5-ビス(N-ドコシ リデンアミノ) ベンズアニリド、

【0043】4′-ヒドロキシ-4-オクタデシルカル ポニルアミノベンズアニリド、4′-ヒドロキシ-3-オクタデシルカルポニルアミノ - 5 - オクタデシルオキ シベンズアニリド、4′-ヒドロキシー3′-メチルー 4-ノニルベンズアニリド、3'-アリル-4'-ヒド ロキシー4-ペンタデシルベンズアニリド、4'-ヒド ロキシー3′ーメトキシー4ーオクタデシルベンズアニ リド、4′-ヒドロキシ-3′-メチル-4-ノニルオ 40 キシベンズアニリド、4′-ヒドロキシ-3′-プロピ ルー4ーノナデシルカルボニルオキシベンズアニリド、 3'-プチル-4'-ヒドロキシ-4-オクタデシルオ キシカルポニルベンズアニリド、3′-ヒドロキシ-4 ーペンタデシルカルポニルオキシベンズアニリド、3 1 ーヒドロキシー4-ノナデシルスルホニルベンズアニリ ド、3′,4′-ジヒドロキシ-4-ヘプタデシルスル ホニルオキシベンズアニリド、3′、4′、5′-トリ ヒドロキシーイーテトラコシルアミノスルホニルベンズ

ルアミノカルボニルベンズアニリド、3′-ヒドロキシ -4- (N-ドデシリデンアミノ) ベンズアニリド、N - 〔4- (3-ヒドロキシフェニルアミノカルポニル) ベンジリデン〕ペンタデシルアミン等が挙げられる。

8

【0044】また、式化6で表される如きアミド化合物 としては、N-シクロヘキシル-4-ヒドロキシベンズ アミド、N-シクロヘキシルメチル-4-ヒドロキシベ ンズアミド、N-オクチル-4-ヒドロキシベンズアミ ド、N-ドデシル-4-ヒドロキシベンズアミド、N-オクタデシルー4-ヒドロキシペンズアミド、N-メチ **ルーN-オクタデシル-4-ヒドロキシベンズアミド、** N-オクタコシルー4-ヒドロキシベンズアミド、N-(3-メチルヘキシル) -4-ヒドロキシベンズアミ ド、N-(8-オクタデセニル)-4-ヒドロキシベン ズアミド、

【0045】4-ヒドロキシー4′ードデシルベンズア ニリド、4-ヒドロキシー4′-テトラデシルベンズア ニリド、N-メチル-4-ヒドロキシ-4'-オクタデ シルベンズアニリド、4-ヒドロキシ-4'-オクチル オキシベンズアニリド、4-ヒドロキシ-4'-オクタ デシルオキシベンズアニリド、4-ヒドロキシー4'-(オクタデシルチオ) ベンズアニリド、4-ヒドロキシ -4'-ペンチルカルポニルベンズアニリド、4-ヒド ロキシー4′-ヘキサデシルカルポニルベンズアニリ ド、4-ヒドロキシ-4'-ヘプタデシルオキシカルボ ニルオキシベンズアニリド、4-ヒドロキシー4'-ド デシルオキシカルポニルベンズアニリド、4-ヒドロキ シー4′ードコシルオキシカルボニルベンズアニリド、 4-ヒドロキシ-4'-ヘプタデシルカルボニルオキシ ベンズアニリド、4-ヒドロキシ-4'-シクロヘキシ ルアミノベンズアニリド、4-ヒドロキシ-4'-オク チルアミノベンズアニリド、4-ヒドロキシ-4'-オ クタデシルアミノペンズアニリド、

【0046】4-ヒドロキシ-4′-ヘプチルカルポニ ルアミノベンズアニリド、4-ヒドロキシー4'-ヘプ タデシルカルボニルアミノベンズアニリド、4-ヒドロ キシー4′-オクタデシルアミノカルポニルベンズアニ リド、4-ヒドロキシー4'-(8-オクタデセニル) アミノカルポニルペンズアニリド、4-ヒドロキシー 4′-ドデシルスルフォニルベンズアニリド、4-ヒド ロキシー4′-オクチルオキシスルフォニルベンズアニ リド、4-ヒドロキシ-4′-オクタデシルオキシスル フォニルベンズアニリド、4-ヒドロキシ-4'-ドデ シルスルフォニルオキシベンズアニリド、N-4-ヒド ロキシベンゾイル-N'-オクタデシリデン-1,4-フェニレンジアミン、N-4-(4-ヒドロキシフェニ ルカルポニルアミノ) ベンジリデンドデシルアミン、4 -ヒドロキシ-4'-オクチルオキシカルポニルアミノ ベンズアニリド、4-ヒドロキシー4′-テトラデシル アニリド、3′,5′-ジヒドロキシー4-ペンタコシ 50 オキシカルボニルアミノベンズアニリド、4-ヒドロキ

シー4'-オクタデシルウレイレンベンズアニリド、

【0047】 Nードデシルー3-ヒドロキシベンズアミ ド、N-オクタデシル-3,4-ジヒドロキシベンズア ミド、N-オクタデシル-2, 3, 4-トリヒドロキシ ベンズアミド、3-ヒドロキシ-4'-ドデシルオキシ ベンズアニリド、N-メチル-4-ヒドロキシ-3'-オクタデシルオキシベンズアニリド、3-ヒドロキシー 4'-オクチルベンズアニリド、3-ヒドロキシー4' ーテトラデシルベンズアニリド、N-メチル-3-ヒド ロキシー4′-オクタデシルベンズアニリド、N-ドデ 10 シル-4-ヒドロキシ-3-メチルベンズアミド、3-メトキシー4-ヒドロキシー4'-オクタデシルオキシ ペンズアニリド、3-アリル-4-ヒドロキシ-4'-オクタデシルオキシベンズアニリド、3-クロロ-4-ヒドロキシー4′ーオクタデシルベンズアニリド、N-オクタデシルー4-ヒドロキシー2,5-ジメチルペン ズアミド、N-オクタデシル-4-ヒドロキシ-3-エ チルベンズアミド、4-ヒドロキシー4'-オクチルオ キシー3′ーメチルペンズアニリド、4-ヒドロキシー 4'-オクタデシルオキシ-3'-クロロベンズアニリ 20 ド、4-ヒドロキシ-3′, 4′-ジデシルオキシベン プアニリド、4-ヒドロキシ-3'-オクタデシルアミ ノー4'-オクタデシルオキシベンズアニリド、4-ヒ ドロキシー2′ークロロー3′,5′ージデシルオキシ ベンズアニリド、4-ヒドロキシ-3', 4'-ジオク タデシルオキシベンズアニリド、4-ヒドロキシー41 -オクチル-3'-メチルベンズアニリド、3-ヒドロ キシー4-メチルー4'-テトラデシルベンズアニリ ド、N-メチル-4-ヒドロキシ-3'-オクタデシル ベンズアニリドなどが挙げられる。

【0048】式化7で表される如きスルホンアミド化合 物としては、4-(N-オクチルスルホニルアミノ)フ ェノール、4- (N-ドデシルスルホニルアミノ) フェ ノール、4- (N-オクタデシルスルホニルアミノ) フ ェノール、4-(N-メチル-N-オクタデシルスルホ ニルアミノ) フェノール、4-(N-3-メチルヘキシ ルスルホニルアミノ) フェノール、

【0049】4′-ヒドロキシ-4-シクロヘキシルベ ンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロキシ-4-オク チルベンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロキシー4 40 ードデシルペンゼンスルホンアニリド、4′ーヒドロキ シー4ードデシルオキシベンゼンスルホンアニリド、 4'-ヒドロキシー4-オクタデシルオキシペンゼンス ルホンアニリド、4′-ヒドロキシ-4-(ドデシルチ オ) ベンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロキシー4 - ヘキシルカルポニルベンゼンスルホンアニリド、4' ーヒドロキシー4-ヘキサデシルカルボニルベンゼンス ルホンアニリド、4′-ヒドロキシ-4-(8-ヘプタ デセニル) カルボニルベンゼンスルホンアニリド、4′

ンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロキシ-4-ドデ シルオキシカルポニルペンゼンスルホンアニリド、 ′-ヒドロキシー4-オクタコシルオキシカルポニルベンゼ ンスルホンアニリド、4′-ヒドロキシ-4-ドデシル カルポニルオキシベンゼンスルホンアニリド、4′-ヒ ドロキシー4-ヘキシルアミノペンゼンスルホンアニリ ド、4′-ヒドロキシ-4-オクタデシルアミノベンゼ ンスルホンアニリド、

10

【0050】4′-ヒドロキシ-4-ヘプタデシルカル ポニルアミノベンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロ キシー4-ドデシルアミノカルボニルベンゼンスルホン アニリド、4′-ヒドロキシ-4-ドデシルスルホニル ペンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロキシ-4-オ クチルオキシスルホニルペンゼンスルホンアニリド、 4′-ヒドロキシ-4-オクタデシルオキシスルホニル ベンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロキシ-4-ド デシルスルホニルオキシベンゼンスルホンアニリド、N ーオクチリデンー4-(4-ヒドロキシフェニル)アミ ノスルホニルアニリン、N-ドデシリデン-4-(4-ヒドロキシフェニル) アミノスルホニルアニリン、N-4-(4-ヒドロキシフェニルアミノスルホニル)ベン ジリデンオクタデシルアミン、4′-ヒドロキシ-4-オクチルオキシカルポニルアミノベンゼンスルホンアニ リド、4′-ヒドロキシ-4-オクタデシルオキシカル ボニルアミノベンゼンスルホンアニリド、4′-ヒドロ キシー4-オクタデシルウレイレンベンゼンスルホンア ニリド、

【0051】3-(N-ドデシルスルホニルアミノ)フ ェノール、4- (N-オクタデシルスルホンアミノ) カ テコール、4- (N-オクタデシルスルホンアミノ) レ ゾルシノール、4- (N-オクタデシルスルホニルアミ ノ) ピロガロール、4′ーヒドロキシー3ーオクチルオ キシベンゼンスルホンアニリド、3′-ヒドロキシ-4 -ドデシルオキシベンゼンスルホンアニリド、N-メチ ルー4'-ヒドロキシー3-オクタデシルオキシベンゼ ンスルホンアニリド、3′-ヒドロキシー4-ドデシル ベンゼンスルホンアニリド、3-メチル-4-(N-ド デシルスルホンアミノ)フェノール、4-メチル-3-(N-テトラデシルスルホンアミノ) フェノール、3′ ーメトキシー4′ーヒドロキシー4ーオクタデシルオキ シベンゼンスルホンアニリド、3′-クロロ-4'-ヒ ドロキシー4ーオクタデシルベンゼンスルホンアニリ ド、4′-ヒドロキシー2、5-ジメチルー4-オクタ デシルベンゼンスルホンアニリド、3 - メチル - 4 -(N-オクタデシルスルホンアミノ) フェノール、4' -ヒドロキシー3、4-ジオクタデシルオキシベンゼン スルホンアニリドなどが挙げられる。

【0052】式化8で表される如きスルフィド化合物と しては、1-(4-ヒドロキシフェニルチオ) ヘキサ ーヒドロキシー4ーオクチルオキシカルボニルオキシベ 50 ン、1-(4-ヒドロキシフェニルチオ)ドデカン、1

7.3

【0058】式化10で表される如きアゾメチン化合物 としては、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)ドデシルアミン、<math>N-(4-ヒドロキシベンジリデン)オクタデシルアミン、

【0059】N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-ヘキシルアニリン、N-(4-ヒドロキシベンジ リデン) - 4'-オクチルアニリン、N-(4-ヒドロ キシベンジリデン) - 4 ' - テトラデシルアニリン、N - (4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-ドデシルオ キシアニリン、N- (4-ヒドロキシベンジリデン) - 10 4'-オクタデシルオキシアニリン、N-(4-ヒドロ キシベンジリデン)-4′-(オクチルチオ)アニリ ン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-ヘキ サデシルカルポニルアニリン、N- (4-ヒドロキシベ ンジリデン) -4'-オクチルオキシカルボニルアニリ ン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-オク タデシルオキシカルボニルアニリン、N-(4-ヒドロ キシペンジリデン) - 4′-ドデシルカルボニルオキシ アニリン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4' ーテトラデシルカルポニルオキシアニリン、N-(4- 20 ヒドロキシベンジリデン) -4'-オクタデシルオキシ カルポニルオキシアニリン、N-(4-ヒドロキシペン ジリデン) -4'-シクロヘキシルアミノアニリン、N - (4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-ドデシルア ミノアニリン、

【0060】N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4′-ヘプタデシルカルポニルアミノアニリン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-ドデシルアミ ノカルポニルアニリン、N- (4-ヒドロキシベンジリ デン) - 4′-オクタデシルアミノカルポニルアニリ ン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-ドデ シルスルフィニルアニリン、N-(4-ヒドロキシベン ジリデン) - 4'-ドデシルスルフォニルアニリン、N - (4-ヒドロキシペンジリデン) -4'-オクタデシ ルスルフォニルアニリン、N-(4-ヒドロキシベンジ リデン) - 4′ - オクチルオキシスルフォニルアニリ ン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-オク タコシルオキシスルフォニルアニリン、N-(4-ヒド ロキシベンジリデン) -4'-(3-メチルヘキシル) オキシスルフォニルアニリン、N-(4-ヒドロキシベ 40 ンジリデン) - 4′-ドデシルスルフォニルオキシアニ リン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4'-(オクチルチオカルポニル) アニリン、N-(4-ヒド ロキシベンジリデン) - 4′-オクチルオキシカルボニ ルアミノアニリン、N-(4-ヒドロキシベンジリデ ン) -4'-オクタデシルオキシカルポニルアミノアニ リン、N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4′-オ クタデシルウレイレンアニリン、

【0061】N-(3-ヒドロキシベンジリデン)ドデシルアミン、N-(3,4-ジヒドロキシベンジリデ 50

ン)オクタデシルアミン、N-(2,4-3)ヒドロキシベンジリデン)オクタデシルアミン、N-(3,4,5)ートリヒドロキシベンジリデン)オクタデシルアミン、N-(4-1)ヒドロキシー3-1メチルベンジリデン)ドデシルアミン、10 (10

14

【0062】式化11で表される如きアゾメチン化合物 としては、N-オクチリデン-4-ヒドロキシアニリン、N-テトラデシリデン-4-ヒドロキシアニリン、 N-オクタデシリデン-4-ヒドロキシアニリン、

【0063】N-(4-ドデシル) ベンジリデン-4' -ヒドロキシアニリン、N-(4-オクチルオキシ)ベ ンジリデン-4'-ヒドロキシアニリン、N-(4-オ クタデシルオキシ) ベンジリデン-4′-ヒドロキシア ニリン、N- (4-オクタデシルチオ) ベンジリデン-4'-ヒドロキシアニリン、N-(4-ウンデシルカル ボニル) ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N - (4-トリデシルカルポニル) ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-ヘプタデシルカルボニ **ル)ベンジリデンー4′-ヒドロキシアニリン、N-**【4-(8-ヘプタデセニリルカルポニル)ペンジリデ ン} -4'-ヒドロキシアニリン、N-(4-ドデシル オキシカルポニル) ベンジリデンー4′ーヒドロキシア ニリン、N- (4-オクタデシルオキシカルボニル) ベ ンジリデン-4'-ヒドロキシアニリン、N-(4-オ クチルカルポニルオキシ) ペンジリデン-4′-ヒドロ キシアニリン、N-(4-オクタデシルカルポニルオキ シ) ペンジリデンー4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-ヘキシルアミノ) ベンジリデン-4'-ヒドロキ シアニリン、N- (4-オクタデシルアミノ) ベンジリ デンー4′ーヒドロキシアニリン、

【0064】N-(4-オクタデシルカルボニルアミノ)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-ドデシルアミノカルボニル)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-オクタデシルアミノカルボニル)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-ドデシルスルフィニル)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-オクチルスルフォニル)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-ドデシルスルフォニル)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-オクチルスルフォニルオキシ)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-ドデシルスルフォニルオキシ)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-ドデシルスルフォニルオキシ)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリン、N-(1-ドデシルオキシスルフォニル)ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニリ

ン、N-(4-オクタデシルオキシスルフォニル)ベン ジリデンー4′ーヒドロキシアニリン、Nー(4ーオク チルチオカルポニル) ベンジリデン-4′-ヒドロキシ アニリン、N-(4-ドデシルオキシカルポニルアミ ノ) ベンジリデン-4'-ヒドロキシアニリン、N-(4-オクタデシルオキシカルポニルアミノ) ベンジリ デン-4'-ヒドロキシアニリン、N-(4-オクタデ シルウレイレン) ベンジリデン-4′-ヒドロキシアニ リン、

【0065】Nードデシリデン-3-ヒドロキシアニリ ン、N-オクタデシリデン-3,4-ジヒドロキシアニ リン、N-オクタデシリデン-3,4,5-トリヒドロ キシアニリン、N- (4-オクタデシル) ベンジリデン -3', 4'-ジヒドロキシアニリン、N-(4-テト ラデシル) ベンジリデン-3′-メチル-4′-ヒドロ キシアニリン、N-(4-テトラデシル-3, 5-ジメ チル) ペンジリデンー4′-ヒドロキシアニリン、N-(4-テトラデシル) ベンジリデン-2'-クロロー 4'-ヒドロキシアニリン、N-(4-オクタデシルー 3-メチル) ペンジリデン-3', 4'-ジヒドロキシ アニリンなどが挙げられる。

【0066】本発明による電子受容性化合物は公知の方 法で製造することができるが、その構造中に大きな脂肪 鎖(疎水基)とフェノール性水酸基(極性基)を有する 為、常温における溶媒溶解性が低いものが多い。それ 故、加熱下で反応を行い、目的とする化合物を製造する ことが好ましい化合物が多い。

【0067】本発明による電子受容性化合物の幾つかの 具体例について、以下にその合成例を示すが本発明は何 等これに限定されるものではない。

【0068】(合成例1)4′-ヒドロキシ-n-ヘプ タデカンアニリド (実施例3) の合成例

窒素雰囲気下、p-アミノフェノール(109g)をメ チルエチルケトン(2000ml)中に懸濁させ、70 ℃に加熱する。懸濁液を激しくかくはんしながら、ヘブ タデカノイルクロリド (152g) を加え、2時間加熱 還流した。この反応液を激しくかくはんしながら、5% 塩酸水溶液500mlを加えた。反応液を室温まで冷却 すると、白色結晶が析出したので減圧下濾別した。メチ ルエチルケトンで再結晶を行い、目的物150gを得 た。収率80%。融点137℃。

【0069】(合成例2)4′-ヒドロキシ-n-ノナ デカンアニリド (実施例4) の合成例

窒素雰囲気下、p-アミノフェノール(109g)をメ チルエチルケトン (2000ml) 中に懸濁させる。こ の懸濁液にトリエチルアミン (253g) を加えた後、 ノナデカノイルクロリド (331g) を加え、2時間加 熱還流した。反応液を室温まで冷却すると、白色結晶が 析出したので減圧下濾別した。メチルエチルケトンより

点138℃。

【0070】(合成例3)4 ーヒドロキシー4-n-オクタデシルオキシベンズアニリド(実施例12)の合

16

窒素雰囲気下、4-n-オクタデシルオキシ安息香酸 (100.0g) 及びジメチルホルムアミド (5ml) をクロロホルム (800ml) に懸濁させ、ここに塩化 チオニル33.4gを加えた。滴下終了後1時間加熱還 流し、対応する酸クロリドを合成した。反応液を冷却 後、この溶液にp-アミノフェノール30.8g及びト リエチルアミン28.6gを加え、2時間加熱還流をし た。反応液を室温まで冷却すると、白色結晶が析出した ので減圧下濾別した。この結晶を蒸留水にて洗浄した 後、イソプロパノールより再結晶を行い、目的物98. 7gを得た。収率80%。融点193℃。

【0071】(合成例4) N-n-オクタデシル-4-ヒドロキシベンズアミド (実施例17) の合成例 窒素雰囲気下、4-アセトキシ安息香酸(100.0 g) およびジメチルホルムアミド (3 m 1) をクロロホ 20 ルム (500ml) に懸濁させ、ここに塩化チオニル (79.2g) を約30分かけて滴下する。滴下終了 後、1時間加熱還流し、対応する酸クロリドを合成し た。反応液を冷却後、この溶液にn-オクタデシルアミ ン(149.6g) およびトリエチルアミン(67.4 g) を加え、3時間加熱還流をした。反応液を室温まで 冷却すると、白色結晶が析出したので減圧下濾別した。 この結晶を蒸留水にて洗浄した後、イソプロパノールよ り再結晶を行い、N-n-オクタデシルー4-アセトキ シベンズアミド (206.0g) を得た。収率86%。 融点106℃。これを、1、4-ジオキサン(1000 m 1) に懸濁させ、ここにKOH水溶液 (50%) (1 60.7g) を加えた。反応溶液の温度を40~45℃ に保ち、一昼夜反応させた。反応終了後、室温まで冷却 し希塩酸を加えると白色結晶が析出したので減圧下濾別 した。この結晶を蒸留水にて洗浄した後、クロロホルム より再結晶を行い、目的物 (137.6g) を得た。収

【0072】(合成例5)4-ヒドロキシ-4´-n-オクタデシルオキシベンズアニリド(実施例18)の合 成例

率74%。融点105℃。

窒素雰囲気下、4-アセトキシ安息香酸(100.0 g) およびジメチルホルムアミド (3m1) をクロロホ ルム(800ml)に懸濁させ、ここに塩化チオニル (79.2g)を約30分かけて滴下する。滴下終了 後、1時間加熱還流し、対応する酸クロリドを合成し た。反応液を冷却後、この溶液にn-オクタデシルオキ シベンズアニリン (200.0g) およびトリエチルア ミン(67.4g)を加え、3時間加熱還流をした。反 応液を室温まで冷却すると、白色結晶が析出したので減 再結晶を行い、目的物323gを得た。収率80%。融 50 圧下濾別した。この結晶を蒸留水にて洗浄した後、イソ

窒素雰囲気下、4-アセトキシ安息香酸(100.0 g) およびジメチルホルムアミド (3 m l) をクロロホ ルム(800ml)に懸濁させ、ここに塩化チオニル (79.2g)を約30分かけて滴下する。滴下終了 後、1時間加熱還流し、対応する酸クロリドを合成し た。反応液を冷却後、この溶液に3´, 4´ージーnー デシルオキシベンズアニリン(225.1g) およびト リエチルアミン (67.4g) を加え、3時間加熱還流 をした。反応液を室温まで冷却すると、白色結晶が析出 したので減圧下濾別した。この結晶を蒸留水にて洗浄し た後、イソプロパノールより再結晶を行い、4-アセト キシー3´, 4´ージーnーデシルオキシベンズアニリ ド (280.5g) を得た。収率89%。融点117 ℃。これを、1、4-ジオキサン(1000ml)に懸 濁させ、ここにKOH水溶液 (50%) (166.3 g) を加えた。反応溶液の温度を40~45℃に保ち、 一昼夜反応さた。反応終了後、室温まで冷却し希塩酸を 30 加えると白色結晶が析出したので減圧下濾別した。この 結晶を蒸留水にて洗浄した後、クロロホルムより再結晶 を行い、目的物(215.6g)を得た。収率83%。 融点137℃。

【0074】(合成例7)4-ヒドロキシ-3´,4´ -ジ-n-オクタデシルオキシベンズアニリド(実施例22)の合成例

窒素雰囲気下、4-アセトキシ安息香酸(100.0g)およびジメチルホルムアミド(3m1)をクロロホルム(800m1)に懸濁させ、ここに塩化チオニル(79.2g)を約30分かけて滴下する。滴下終了後、1時間加熱還流し、対応する酸クロリドを合成した。反応液を冷却後、この溶液に3´,4´ージーnーオクタデシルオキシペンズアニリン(349.7g)およびトリエチルアミン(67.4g)を加え、3時間加熱還流をした。反応液を室温まで冷却すると、白色結晶が折出したので減圧下濾別した。この結晶を蒸留水にて洗浄した後、イソプロパノールより再結晶を行い、4ーアセトキシー3´,4´ージーnーオクタデシルオキシベンズアニリド(351.7g)を得た。収率80%。

融点107°。これを、1,4-ジオキサン(1000 m 1)に懸濁させ、ここにKOH水溶液(50%)(149.5g)を加えた。反応溶液の温度を40~45° に保ち、一昼夜反応させた。反応終了後、室温まで冷却し希塩酸を加えると白色結晶が折出したので減圧下濾別した。この結晶を蒸留水にて洗浄した後、クロロホルムより再結晶を行い、目的物(277.5g)を得た。収率82%。融点133°。

18

【0075】(合成例8)4-(N-オクタデシルスル ホニルアミノ)フェノール(実施例25)の合成例 窒素雰囲気下、オクタデカンスルホン酸ナトリウム(357g)をジメチルホルムアミド(600ml)に懸濁させ、ここに塩化チオニル(119g)を約30分かけて滴下する。滴下終了後、80℃で1時間加熱し、対応するスルホン酸クロリドを合成した。反応液を冷却後、この溶液にp-アミノフェノール(109g)およびトリエチルアミン(202g)を加え、3時間加熱湿流をした。反応終了後、反応液を水に注ぐと白色固体が析出した。5%塩酸を加えpHを酸性にした後、白色固体を 波圧下濾別した。メチルエチルケトンより再結晶を行い、目的物(302g)を得た。収率71%。融点142℃。

【0076】(合成例9) 1-(4-ヒドロキシフェニルチオ)-n-オクタデカン(実施例31)の合成例 窒素雰囲気下、p-ヒドロキシチオフェノール(126g)をジメチルホルムアミド(600m1)に溶解し、炭酸カリウム(152g)を加えた。ここにオクタデシルクロリド(318g)を加え、<math>80で2時間加熱した。反応終了後、反応液を水に注ぐと白色固体が折出した。反応終了後、反応液を水に注ぐと白色固体が折出した。5%塩酸を加えpHを酸性にした後、白色固体を減圧下離別した。メチルエチルケトンより再結晶を行い、目的物(261g)を得た。収率70%。融点95℃。【0077】(合成例10)4 $^-$ -ヒドロキシー4- $^-$ 1カイダデシルオキシジフェニルスルフィド(実施例39)の合成例

窒素雰囲気下、4,4 ´ージヒドロキシジフェニルスルフィド(100.0g)、nーオクタデシルプロマイド(179.0g)および炭酸カリウム(89.0g)をジメチルホルムアミド(1000ml)に加え、反応溶液を90~100℃に保ち3時間反応させた。反応終了後、反応液を氷水にあけると、白色結晶が析出したので減圧下濾別した。この結晶を蒸留水にて洗浄した後、イソプロパノールより再結晶を行い、結晶化したピスアルキル体を濾別した。濾液を濃縮し残渣をnーヘキサンに懸濁加熱し、熱時濾過を行った。その濾液を濃縮し、目的物(70.8g)を得た。収率28%。融点81℃。【0078】(合成例11)4 ´ーヒドロキシー4ーnーヘプタデシルカルボニルアミノジフェニルスルフィド(実施例40)の合成例

50 窒素雰囲気下、ステアリン酸 (100.0g) およびジ

メチルホルムアミド (3m1) をクロロホルム (500 m1) に懸濁させ、ここに塩化チオニル (50.2g) を約30分かけて滴下した。滴下終了後、1時間加熱還流し、対応する酸クロリドを合成した。窒素雰囲気下、4~-ヒドロキシー4-n-アミノジフェニルスルフィド (76.4g) およびトリエチルアミン (42.4g) をクロロホルム (500m1) に懸濁し、懸濁液を激しく攪拌しながら、冷却した先ほどの酸クロリドを加え、3時間加熱還流をした。反応液を室温まで冷却すると、白色結晶が折出したので減圧下濾別した。この結晶を蒸 10 留水にて洗浄した後、イソプロパノールより再結晶を行い、目的物 (122.4g) を得た。収率72%。融点143℃。

【0079】(合成例12) N-(4-ヒドロキシフェニル)-N'-n-オクタデシル尿素(実施例44)の合成例

窒素雰囲気下、p-アミノフェノール(109g)をメチルエチルケトン(2000ml)中に懸濁させ、70℃に加熱する。懸濁液を激しくかくはんしながら、n-オクタデシルイソシアネート(296g)を約30分か 20けて滴下する。この時、反応熱が発生する為、反応液の温度を70~75℃に保つ速度でn-オクタデシルイソシアネートを滴下する。滴下終了後、反応溶液の温度を75~80℃に上げ、更に30分反応させる。反応終了後、室温まで冷却すると、白色固体が析出する。ろ過して溶媒を除去し、減圧乾燥すると、ほぼ純粋な目的物(385g)が得られる。収率95%。融点144℃。

【0080】(合成例13) N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-n-オクタデシルアミン(実施例<math>49) の合成例

窒素雰囲気下、p-ヒドロキシベンズアルデヒド99.6g、<math>n-オクダデシルアミン200.0g及びp-トルエンスルホン酸13.4gをトルエン1200mlに加え、加熱還流すると同時に共沸する水を除去した。約2時間後、反応液を室温まで冷却すると結晶が析出したのでこれを減圧下濾別した。この結晶をイソプロパノールから再結晶を行い、目的物207.9gを得た。収率75%。融点101 $\mathbb C$ 。

【0081】(合成例14)N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4-n-オクダデシルオキシアニリン(実 40 施例51)の合成例

窒素雰囲気下、pーヒドロキシベンズアルデヒド99. 6g、nーオクダデシルアニリン250.0g及びpートルエンスルホン酸12.5gをトルエン2000mlに加え、加熱環流すると同時に共沸する水を除去した。約3時間後、反応液を室温まで冷却すると結晶が析出したのでこれを減圧下濾別した。この結晶をイソプロパノールから再結晶を行い、目的物225.4gを得た。収率70%。融点125℃。

【0082】 (合成例15) N- (4^- -n-オクタデ 50 クチルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-フ

20 シルオキシ) ベンジリデン-4-ヒドロキシアニリン (実施例54)の合成例

窒素雰囲気下、p-オクタデシルオキシベンズアルデヒド100.0g、p-アミノフェノール32.0g及びp-トルエンスルホン酸4.8gをトルエン1000mlに加え、加熱選流すると同時に共沸する水を除去した。約2時間後、反応液を室温まで冷却すると結晶が折出したのでこれを減圧下濾別した。この結晶をイソプロパノールから再結晶を行い、目的物101.9gを得た。収率82%。酸点115℃。

【0083】本発明による電子受容性化合物はそれぞれ 1種または2種以上を混合して使用してもよく、通常無 色ないし淡色の染料前駆体に対する本発明による電子受 容性化合物の使用量は、5~5000重量%、好ましく は10~3000重量%である。

【0084】本発明に用いられる通常無色ないし淡色の電子供与性染料前駆体としては一般に感圧記録紙、感熱記録紙、感熱転写紙等に用いられるものに代表されるが、特に制限されるものではない。具体的な例としては、例えば下記に挙げるものなどがあるが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0085】(1)トリアリールメタン系化合物 3, 3-ビス (p-ジメチルアミノフェニル) -6-ジ メチルアミノフタリド(クリスタルバイオレットラクト ン)、3、3-ピス(p-ジメチルアミノフェニル)フ タリド、3-(p-ジメチルアミノフェニル)-3-(1, 2-ジメチルインドール-3-イル) フタリド、 3- (p-ジメチルアミノフェニル) -3- (2-メチ ルインドール-3-イル) フタリド、3-(p-ジメチ 30 ルアミノフェニル) -3-(2-フェニルインドール-3-イル) フタリド、3, 3-ビス(1, 2-ジメチル インドールー3ーイル)-5-ジメチルアミノフタリ ド、3,3-ビス(1,2-ジメチルインドール-3-イル) -6-ジメチルアミノフタリド、3.3-ピス (9-エチルカルパゾール-3-イル) -5-ジメチル アミノフタリド、3,3-ピス(2-フェニルインドー ルー3-イル) -5-ジメチルアミノフタリド、3-p ージメチルアミノフェニルー3-(1-メチルピロール -2-イル) -6-ジメチルアミノフタリド等、

【0086】(2) ジフェニルメタン系化合物 4, 4' - ビス (ジメチルアミノフェニル) ベンズヒド リルベンジルエーテル、N - クロロフェニルロイコオー ラミン、N - 2, 4, 5 - トリクロロフェニルロイコオーラミン等、

【0087】(3)キサンテン系化合物 ローダミンBアニリノラクタム、ローダミンB-p-ク ロロアニリノラクタム、3-ジエチルアミノ-7-ジベンジルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-オ クチルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-フ

ェニルフルオラン、 $3-\Im$ エチルアミノ-7-クロロフルオラン、 $3-\Im$ エチルアミノ-6-クロロ-7-メチルフルオラン、 $3-\Im$ エチルアミノ-7-(3, $4-\Im$ クロロアニリノ)フルオラン、 $3-\Im$ エチルアミノ-7-(2-クロロアニリノ)フルオラン、

【0088】 3-ジェチルアミノ-6-メチル-7-ア ニリノフルオラン、3-(N-エチル-N-トリル) アミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-ピペリジノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-(N-エチル-N-トリル) アミノ-6-メチル-7-フェネチルフルオラン、3-ジエチルアミノ-7-(4-ニトロアニリノ) フルオラン、3-ジブチルアミノ-7-(4-エトロアニリノ) フルオラン、3-ジブチルアミノ-7-グロピル) アミノ-7-0・メチル-7-7・アニリノフルオラン、3-(7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン、7-1・アニリノフルオラン等、

【0089】(4) チアジン系化合物 ベンゾイルロイコメチレンブルー、p-ニトロベンゾイ ルロイコメチレンブルー等、

【0090】(5)スピロ系化合物

3-メチルスピロジナフトピラン、3-エチルスピロジ ナフトピラン、3, 3^{\prime} -ジクロロスピロジナフトピラ ン、3-ベンジルスピロジナフトピラン、3-メチルナ フト-(3-メトキシベンゾ)スピロピラン、3-プロ ピルスピロベンゾピラン等

【0091】本発明に用いる前記通常無色ないし淡色の 30 電子供与性染料前駆体はそれぞれ1種または2種以上を混合して使用してもよい。

【0092】次に本発明の可逆性感熱記録材料の具体的 製造方法について述べるが、本発明はこれに限定される ものではない。

【0093】本発明の可逆性感熱記録材料の製造方法の 具体例としては、本発明に用いる通常無色ないし淡色の 電子供与性染料前駆体と本発明による電子受容性化合物 を主成分とし、これらを支持体上に塗布して可逆性感熱 記録層を形成する方法が挙げられる。

【0094】本発明に用いる通常無色ないし淡色の電子 供与性染料前駆体と、本発明による電子受容性化合物を 可逆性感熱記録層に含有させる方法としては、各々の化 合物を単独で溶媒に溶解もしくは分散媒に分散してから 混合する方法、各々の化合物を混ぜ合わせてから溶媒に 溶解もしくは分散媒に分散する方法、各々の化合物を加 熱溶解し均一化した後冷却し、溶媒に溶解もしくは分散 媒に分散する方法等が挙げられるが特定されるものでは ない。

【0095】また、可逆性感熱記録層の強度を向上する 50 の面に、電気的、磁気的、光学的に情報が記録可能な材

等の目的でパインダーを可逆性感熱記録層中に添加する 事も可能である。本発明に用いるパインダーの具体例と しては、デンプン類、ヒドロキシエチルセルロース、メ チルセルロース、カルポキシメチルセルロース、ゼラチ ン、カゼイン、ポリビニルアルコール、変性ポリビニル アルコール、ポリアクリル酸ソーダ、アクリル酸アミド **/アクリル酸エステル共重合体、アクリル酸アミド/ア** クリル酸エステル/メタクリル酸3元共重合体、スチレ ン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩、エチレン/ 無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩等の水溶性高分 子、ポリ酢酸ピニル、ポリウレタン、ポリアクリル酸エ ステル、スチレン/プタジエン共重合体、アクリロニト リル/プタジエン共重合体、アクリル酸メチル/プタジ エン共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重合体等のラテ ックスなどがあげられるがこれらに限定されるものでは ない。

22

【0096】また、可逆性感熱記録層の発色感度及び消 色温度を調節するための添加剤として、熱可融性物質を 可逆性感熱記録層中に含有させることができる。本発明 に用いる熱可融性物質としては60℃~200℃の融点 を有するものが好ましく、特に80℃~180℃の融点 を有するものが好ましい。また、一般の感熱記録紙に用 いられている増感剤を使用することもできる。本発明に 用いる熱可融性物質の具体例としては、N-ヒドロキシ メチルステアリン酸アミド、ステアリン酸アミド、パル ミチン酸アミドなどのワックス類、2-ペンジルオキシ ナフタレン等のナフトール誘導体、p-ベンジルピフェ ニル、4-アリルオキシピフェニル等のピフェニル誘導 体、1,2-ピス(3-メチルフェノキシ)エタン、 2, 2'-ピス(4-メトキシフェノキシ)ジエチルエ ーテル、ビス (4-メトキシフェニル) エーテル等のポ リエーテル化合物、炭酸ジフェニル、シュウ酸ジベンジ ル、シュウ酸ビス(p-メチルペンジル)エステル等の 炭酸またはシュウ酸ジエステル誘導体等があげられ、2 種以上併用して添加することもできる。

【0097】本発明の可逆性感熱記録材料に用いる支持体としては、紙、各種不織布、織布、合成樹脂フィルム、合成樹脂ラミネート紙、合成紙、金属箔、ガラス等、あるいはこれらを組み合わせた複合シートを目的に応じて任意に用いることができるが、これらに限定されるものではない。

【0098】本発明の可逆性感熱記録材料の層構成は、可逆性感熱記録層のみであっても良い。必要に応じて、可逆性感熱記録層上に保護層を設けることも又、可逆性感熱記録層と支持体の間に中間層を設けることもできる。この場合、保護層および/または中間層は2層ないしは3層以上の複数の層から構成されていてもよい。更に可逆性感熱記録層中および/または他の層および/または可逆性感熱記録層が設けられている面または反対側の面に、衝気的、磁気的、光学的に情報が記録可能な材

料を含んでも良い。また、可逆性感熱記録層が設けられている面と反対側の面にカール防止、帯電防止を目的としてバックコート層を設けることもできる。

【0099】可逆性感熱配録層は、各発色成分を微粉砕して得られる各々の分散液を混合し、支持体上に塗布乾燥する方法、各発色成分を溶媒に溶解して得られる各々の溶液を混合し、支持体上に塗布乾燥する方法などにより得ることができる。この場合、例えば、各発色成分を一層ずつに含有させ、多層構造としてもよい。

【0100】また、可逆性感熱記録層及び/または保護 10層及び/または中間層には、ケイソウ土、タルク、カオリン、焼成カオリン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化ケイ素、水酸化アルミニウム、尿素 - ホルマリン樹脂等の顔料、その他に、ヘッド摩耗防止、スティッキング防止等の目的でステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム等の高級脂肪酸金属塩、パラフィン、酸化パラフィン、ポリエチレン、酸化ポリエチレン、ステアリン酸アミド、カスターワックス等のワックス類を、また、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム等の分散剤、さらに界面活性剤、蛍光染料など 20を含有させることもできる。

[0101]

【作用】本発明の可逆性感熱記録材料における画像の形成及び消去の原理は以下の様に考えている。本発明に用いる通常無色ないし淡色の電子供与性染料前駆体は、フェノール性化合物のような電子受容性化合物と共に加熱すると電子供与性染料前駆体から電子受容性化合物への電子移動が起こり発色する。この時、電子受容性化合物分子は発色した染料分子の極めて近傍に存在していると考えられる。また、発色した染料分子から電子受容性化分分子を引き離すと、発色した染料分子は再び電子を受け取り、発色前の電子供与性染料前駆体の状態となる。本発明は加熱により、電子受容性化合物分子と電子供与性染料前駆体分子(染料分子)との距離を変化させ発色及び消色を行うものと考えられる。

【0102】さらに詳しく述べるならば、本発明による電子受容性化合物は、その構造の中に大きな脂肪鎖を持つため、本発明に用いる電子供与性染料前駆体分子および発色した染料分子との相溶性は非常に低い。それ故、分子が自由に運動できる溶融状態では、電子供与性染料前駆体分子と本発明による電子受容性化合物分子は互いにある割合で溶け合い発色状態となるが、発色している溶融状態の混合物をゆっくり冷却すると、降温するに従い相分離しながら固化する為に消色する。一方、急速な冷却(急速な固化)を行うと、相分離が起こる前、即ち発色状態を保持したままで固化する。すなわち、本発明の可逆性感熱記録材料は、加熱後の冷却速度の違いにより、電子供与性染料前駆体と本発明による電子受容性化合物との相溶状態および相分離状態を作りだし、発色状態および消色状態を発現させるものである。

24

【0103】本発明の可逆性感熱記録材料において、発 色を行うには加熱に引き続き急速な冷却が起これば良 く、消色を行うには加熱後の冷却速度が遅ければ良い。 例えば、適当な熱源(サーマルヘッド、レーザー光、熱 ロール、熱スタンプ、髙周波加熱、電熱ヒーターからの 輻射熱、熱風等)で比較的長い時間加熱すると、記録層 だけでなく支持体等も加熱される為に冷却速度が遅く、 相分離状態(消色状態)になる。一方、適当な方法で加 熱した後、低温の金属プロックなどを押し当てる等して 急速に冷却することにより、発色状態を発現させること ができる。また、サーマルヘッド、レーザー光等を用い て極めて短い時間だけ加熱すると、加熱終了後に直ちに 冷却(固化)が始まる為、発色状態を発現させることが できる。従って、同じ加熱温度および/または同じ熱源 を用いても、冷却速度を制御することにより発色状態お よび消色状態を任意に発現させることができる。

[0104]

【実施例】以下実施例によって本発明を更に詳しく説明 する。

【0105】実施例1

(A) 可逆性感熱塗液の作成

染料前駆体である3-ジーn-ブチルアミノー6-メチルー7-アニリノフルオラン40部を2.5%ポリビニルアルコール水溶液90部と共にボールミルで24時間粉砕し、染料前駆体分散液を得た。次いで4′ーヒドロキシーn-ヘブタンアニリド100部を2.5%ポリビニルアルコール水溶液400部と共にボールミルで24時間粉砕し分散液を得た。上記2種の分散液を混合した後、10%ポリビニルアルコール水溶液200部、水400部を添加、よく混合し、可逆性感熱塗液を作成した。

【0106】(B)可逆性感熱記録材料の作成

(A) で調製した可逆性感熱塗液をポリエチレンテレフタレート (PET) シートに、固形分塗抹量4g/m²となる様に塗抹し、乾燥後、スーパーカレンダーで処理して可逆性感熱記録材料を得た。

【0107】 実施例2~55

実施例1で用いた4′ーヒドロキシーnーヘプタンアニリドの分散液のかわりに、各々下記に記した化合物100部を2.5%ポリビニルアルコール水溶液400部と共にボールミルで24時間粉砕して得た分散液を使用した他は、実施例1と同様にして、可逆性感熱記録材料を得た。

(実施例2) 4′-ヒドロキシ-n-トリデカンアニリド、(実施例3) 4′-ヒドロキシ-n-ヘプタデカンアニリド、(実施例4) 4′-ヒドロキシ-n-ノナデカンアニリド、(実施例5) 3′-ヒドロキシ-n-ノナデカンアニリド、(実施例6) 4′-ヒドロキシ-10-n-オクタデセンアニリド、(実施例7) 4′-ヒドロキシ-n-ドコサンアニリド、(実施例8) 4′-

ヒドロキシー4-n-ヘキシルペンズアニリド、(実施 例9) 4′-ヒドロキシ-4-n-ドデシルベンズアニ リド、(実施例10)4′-ヒドロキシ-4-n-テト ラデシルオキシベンズアニリド、(実施例11)4′-ヒドロキシー4-n-オクタデシルベンズアニリド、 (実施例12) 4′-ヒドロキシ-4-n-オクタデシ ルオキシベンズアニリド、(実施例13)4′-ヒドロ キシー4-n-オクタデシルカルポニルアミノベンズア 二リド、(実施例14) 4′-ヒドロキシ-3-n-オ クタデシルカルポニルアミノ-5-n-オクタデシルオ キシベンズアニリド、(実施例15) N-n-オクチル -4-ヒドロキシペンズアミド、(実施例16) N-n ードデシルー4ーヒドロキシベンズアミド、(実施例1) 7) N-n-オクタデシル-4-ヒドロキシペンズアミ ド、(実施例18) 4-ヒドロキシ-4'-n-オクタ デシルオキシベンズアニリド、(実施例19)4-ヒド ロキシー4′-n-ドデシルベンズアニリド、(実施例 20) 4-ヒドロキシ-4'-n-テトラデシルベンズ アニリド、(実施例21) 4-ヒドロキシ-3', 4' -ジ-n-デシルオキシベンズアニリド、(実施例2 2) 4-ヒドロキシー3', 4'-ジーn-オクタデシ ルオキシベンズアニリド、(実施例23) 4- (N-n -オクチルスルホニルアミノ)フェノール、(実施例2 4) 4- (N-n-ドデシルスルホニルアミノ) フェノ ール、(実施例25) 4- (N-n-オクタデシルスル ホニルアミノ)フェノール、(実施例26)4′-ヒド ロキシー4-n-ドデシルベンゼンスルホンアニリド、 (実施例27) 4′-ヒドロキシ-4-n-ドデシルオ キシベンゼンスルホンアニリド、(実施例28)4′-ヒドロキシー4-n-オクタデシルオキシベンゼンスル ホンアニリド、(実施例29)1-(4-ヒドロキシフ ェニルチオ) - n - ヘキサン、(実施例30) 1- (4 -ヒドロキシフェニルチオ) -n-ドデカン、(実施例 31) 1-(4-ヒドロキシフェニルチオ)-n-オク タデカン、(実施例32)1-(3-ヒドロキシフェニ ルチオ) - n - オクタデカン、(実施例33)1-(4 -ヒドロキシフェニルチオ) -9-n-オクタデセン、 (実施例34) 1- (4-ヒドロキシフェニルチオ) n-ドコサン、(実施例35) 4'-ヒドロキシー4n-ヘキシルジフェニルスルフィド、(実施例36) 4′-ヒドロキシ-4-n-ドデシルジフェニルスルフ ィド、(実施例37)4′-ヒドロキシ-4-n-テト ラデシルオキシジフェニルスルフィド、(実施例38) 4'-ヒドロキシ-4-n-オクタデシルジフェニルス ルフィド、(実施例39)4′-ヒドロキシ-4-n-オクタデシルオキシジフェニルスルフィド、 (実施例4 0) 4'-ヒドロキシ-4-n-オクタデシルカルボニ ルアミノジフェニルスルフィド、(実施例41)4′-ヒドロキシー3、4ージーnーデシルオキシジフェニル スルフィド、(実施例42) N-(4-ヒドロキシフェ 50

ニル) - N′-n-ヘキシル尿素、(実施例43) N-(4-ヒドロキシフェニル) - N′-n-ドデシル尿素、(実施例44) N-(4-ヒドロキシフェニル) - N′-n-オクタデシル尿素、(実施例45) N-(3

26

- ヒドロキシフェニル) - N´ - n - オクタデシル尿素、(実施例46) N - (4-ヒドロキシフェニル) - N´ - (9-n-オクタデセニル) 尿素、(実施例4

7) N- (4-ヒドロキシフェニル) -N'-n-ドコシル尿素、(実施例48) N- (4-ヒドロキシベンジリデン) -n-デシルアミン、(実施例49) N- (4

ーヒドロキシベンジリデン)-n-オクタデシルアミン、(実施例 5 0)N- (4-ヒドロキシベンジリデン)-4-n-テトラデシルアニリン、(実施例 5 1)

N-(4-ヒドロキシベンジリデン)-4-n-オクタデシルオキシアニリン、(実施例52)<math>N-n-テトラデシリデン-4-ヒドロキシアニリン、(実施例53)<math>N-(4'-n-テトラデシル) ベンジリデン-4-ヒ

ドロキシアニリン、(実施例54)N-(4'-n-オ クタデシルオキシ)ベンジリデン-4-ヒドロキシアニ リン、(実施例55)N-(4'-n-オクタデシルチ

オ) ペンジリデン-4-ヒドロキシアニリン、

【0108】比較例1

実施例1で用いた4′ーヒドロキシーnーヘプタンアニリドの分散液のかわりに、没食子酸とステアリルアミンとの塩100部を2.5%ポリピニルアルコール水溶液400部と共にボールミルで24時間粉砕して得た分散液を使用した他は、実施例1と同様にした。

【0109】比較例2

実施例1で用いた4′-ヒドロキシ-n-ヘプタンアニリンドの分散液のかわりに、2,2-ピス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン100部を2.5%ポリピニルアルコール水溶液400部と共にボールミルで24時間粉砕して得た分散液を使用した他は、実施例1と同様にした。

【0110】比較例3

実施例1で用いた4′ーヒドロキシーnーヘブタンアニリドの分散液のかわりに、4ーヒドロキシ安息香酸ベンジル100部を2.5%ポリビニルアルコール水溶液400部と共にボールミルで24時間粉砕して得た分散液を使用した他は、実施例1と同様にした。

【0111】試験1 (発色濃度=熱応答性)

実施例 $1\sim5$ 5 および比較例 $1\sim3$ で得た感熱記録材料を、京セラ製印字ヘッドK J T -2 5 6 -8 MGF 1 付き大倉電気製感熱ファクシミリ印字試験機 T H -P MDを用いて印加パルス 1 . 0 ミリ秒で印加電圧 2 6 ボルトの条件で印字し、得られた発色画像の濃度を濃度計マクベス R D 9 1 8 を用いて測定した。結果を表 $1\sim6$ に示した

【0112】試験2 (発色濃度の経時変化=画像安定性)

実施例1~55および比較例1~3で得た感熱記録材料 を、京セラ製印字ヘッドKJT-256-8MGF1付 き大倉電気製感熱ファクシミリ印字試験機TH-PMD を用いて、印加パルス1.0ミリ秒で印加電圧26ボル トの条件で印字し、温度25℃、相対温度60%の雰囲 気下に96時間保存した後、試験1と同様にして、発色 部の濃度を測定し、下記数1により画像残存率を計算し た。結果を表1~6に示した。

[0113]

【数1】A=(C/B)×100

A:画像残存率(%) B:試験前の画像濃度 *C:試験後の画像濃度

【0114】試験3 (画像の消去性)

実施例1~55および比較例1~3で得た感熱記録材料 を、京セラ製印字ヘッドKJT-256-8MGF1付 き大倉電気製感熱ファクシミリ印字試験機TH-PMD を用いて印加パルス1.0ミリ秒で印加電圧26ポルト の条件で印字し、これを熱スタンプを用いて120℃で 1秒間加熱した後、試験1と同様にして濃度を測定し た。結果を表1~6に示した。

10 [0115] 【表1】

試験1	_

		試験1 発色部の濃度	試験2 画像残存率	試験3 消去部の濃度	コントラ スト
実施例	1	1.15	96%	0.58	Δ
実施例	2	0.97	94%	0.23	0
実施例	3	0.95	93%	0.12	0
実施例	4	0.91	92%	0.06	0
実施例	5	1.05	94%	0.52	Δ
実施例	6	0.92	95%	0.07	0
実施例	7	0.90	94%	0.09	0
実施例	8	1.31	95%	0.65	Δ
実施例	9	1.11	91%	0.31	0
実施例1	. 0	1.01	92%	0.26	0

[0116]

※ ※【表2】

	試験1 発色部の濃度	試験2 画像残存率	試験3 消去部の濃度	コントラ スト
実施例11	1.09	93%	0.09	0
実施例12	0.99	91%	0.08	0
実施例13	1.00	94%	0.12	0
実施例14	0.88	96%	0.07	0
実施例15	1.20	97%	0.62	Δ
実施例16	1.17	95%	0.37	0
実施例17	1.15	93%	0.22	0
実施例18	1.00	92%	0.13	0
実施例19	1.15	95%	0.31	0
実施例20	1.12	92%	0.11	0

[0117]

50 【表3】

29

	試験1 発色部の濃度	試験2 画像残存率	試験3 消去部の濃度	コントラ スト
実施例21	1.17	93%	0.21	0
実施例22	1. 15	92%	0.15	0
実施例23	1.18	97%	0.58	Δ
実施例24	1.15	96%	0.34	0
実施例25	1.15	94%	0.21	0
実施例26	1.12	92%	0.13	0
実施例27	1.15	93%	0.27	0
実施例28	1.12	92%	0.10	0
実施例29	1.25	96%	0.65	Δ
実施例30	1.03	92%	0.27	0

[0118]

* *【表4】

	試験1 発色部の濃度	試験2 画像残存率	試験3 消去部の濃度	コントラスト
実施例31	0.88	91%	0.12	0
実施例32	0.99	92%	0.22	0
実施例33	0.92	90%	0.11	0
実施例34	0.90	94%	0.09	0
実施例35	1.12	94%	0.56	Δ
実施例36	1.09	90%	0.32	0
実施例37	1.07	91%	0.24	0
実施例38	1.07	92%	0.09	0
実施例39	1.12	92%	0.08	0
実施例40	1.15	93%	0.13	0

[0119]

【表5】

31

	試験1 発色部の濃度	試験2 画像残存率	試験3 消去部の濃度	コントラ スト
実施例41	1.17	94%	0.10	0
実施例42	1.40	97%	0.65	Δ
実施例43	1.35	94%	0.22	0
実施例44	1.36	96%	0.07	0
実施例45	1.44	98%	0.59	Δ
実施例46	1.34	95%	0.09	0
実施例47	1.35	96%	0.08	0
実施例48	1.20	94%	0.35	0
実施例49	1.00	92%	0.08	0
実施例50	0.98	93%	0.06	0

[0120]

* *【表6】

	試験1 発色部の濃度	試験2 画像残存率	試験3 消去部の濃度	コントラ スト
実施例51	1.05	93%	0.07	0
実施例52	1.10	95%	0.40	Δ
実施例53	0.99	91%	0.22	0
実施例54	1.01	93%	0.09	0
実施例55	1.01	91%	0.12	0
比較例 1	0.47	56%	0.23	Δ
比較例 2	1.37	99%	1.28	×
比較例 3	1.33	78%	1.18	×

【0121】表1~6中、○は消去部の濃度が発色部の 濃度の30%未満で発色部と消去部のコントラストが良 好、△は消去部の濃度が発色部の濃度の30%以上80 %未満でコントラストが不十分、×は消去部の濃度が発 色部の濃度の80%以上で可逆性が認められないことを 表す。

[0122]

【発明の効果】表1~6に示したように、通常無色ない し淡色の電子供与性染料前駆体と、加熱後の冷却速度の 違いにより該染料前駆体に可逆的な色調変化を生じせしめる電子受容性化合物とを含有する可逆性感熱記録材料において、炭素数6以上の脂肪族炭化水素基を少なくとも一つ有するフェノール性化合物を電子受容性化合物として用いることにより、良好なコントラストで画像の形成・消去が可能で、日常生活の環境下で経時的に安定な画像を保持可能な可逆性感熱記録材料を得ることができた。

フロントページの続き

(31)優先権主張番号 特願平4-282954

(32)優先日

平4 (1992)10月21日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願平4-282955

(32)優先日

平4 (1992)10月21日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(31)優先権主張番号 特願平4-282956

(32)優先日 平4 (1992)10月21日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願平4-294888

(32)優先日

平4 (1992)11月4日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願平4-294890

(32)優先日

平4 (1992)11月4日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願平4-313596

(32)優先日

平4 (1992)11月24日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(72)発明者 飯田 和之

東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱

製紙株式会社内

(72)発明者 佐野 秀和

東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱

製紙株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the	items checked:
□ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	S
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	•
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOF	R QUALITY
□ other:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.